

姓名:	史迅	性别:	男
专家类别:	研究员; 百人	学历:	博士研究生
电话:	021-52412803	传真:	无
电子邮件:	xshi@mail.sic.ac.cn	个人主页:	无
邮政编码:	200050	通讯地址:	无



简历:

史迅，研究员，博士生导师。1976年生，1995年毕业于江苏常州高级中学；2000年毕业于清华大学材料科学与工程系，获工学学士学位；2005年毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所工学博士学位；2005年11月进入美国密歇根大学物理系Ctirad Uher教授课题组从事博士后的研究工作；2007年10月进入美国optimal公司进行热电材料研究工作；2010年入选中科院“百人计划”进入上海硅酸盐研究所工作。2010年获国际热电学会2010年Young Investigator Award奖；2011年获上海市浦江人才资助；2012年获基金委“优秀青年科学基金”资助。Nat. Mater., Phy. Rev. Lett., J. Am. Chem. Soc., Adv. Func. Mater., Phys. Rev. B, Appl. Phys. Lett., Acta Mater., J. Appl. Phys. 等 SCI 收录期刊上发表论文50余篇，被引700余次。申请国专利十余项，其中4项已授权。

研究方向:

热电能量转换材料

半导体材料中的电、热、磁耦合效应

职称:

正高

职务:

社会任职:

获奖及荣誉:

国际热电学会青年科学家奖

国家自然科学基金“优秀青年科学基金”

中科院百人计划

浦江人才

上海市自然科学一等奖（排名第三）

代表论著:

1. Shi X., Chen L., Yang J., Meissner G. P., “Enhanced Thermoelectric Figure of Merit of CoSb₃ via Large-defect Scattering”, Appl. Phys. Lett. 84, 2301-2303 (2004).
2. Shi X., Zhang W., Chen L. D., Yang J., “Filling Fraction Limit for Intrinsic Voids in Crystal: Doping in Skutterudites”, Phys. Rev. Lett. 95, 185503 (2005).
3. Zhao X. Y., Shi X., Chen L. D., Zhang W. Q., Zhang W. B., and Pei Y. Z., “Synthesis and Thermoelectric Properties of Sr-filled Skutterudite S_ryCo₄Sb₁₂”, J. Appl. Phys. 99 (2006).
4. Zhao X. Y., Shi X., Chen L. D., Zhang W. Q., Bai S. Q., Pei Y. Z., Li X. Y., and Goto T., “Synthesis of Yb/Co₄Sb₁₂/Yb₂O₃ Composites and Their Thermoelectric Properties”, Phys. Lett. 89, 092121 (2006).

5. Pei Y. Z., Chen L. D., Zhang W., Shi X., Bai S. Q., Zhao X. Y., Mei G. Z., Li X. Y., "Synthesis and Thermoelectric Properties of $KyCo_4Sb_{12}$ " , Appl. Phys. Lett. 89, 221107 (2006).
6. Shi X., Zhou Z., Zhang W., Chen L. D., Yang J., and Uher C., "Solid Solubility of Ir and Rh at the Co Site of Skutterudites" , J. Appl. Phys. 101, 123525 (2007).
7. Shi X., Zhang W., Chen L. D., Yang J., and Uher C., "Theoretical Study of the Filling Fraction Limits for Impurities in $CoSb_3$ " , Phys. Rev. B 75, 235208 (2007).
8. Shi X., Chen L. D., Bai S. Q., Huang X. Y., Zhao X. Y., Yao Q., and Uher C., "Influence of Fullerene Dispersion on High Temperature Thermoelectric Properties of $BayCo_4Sb_{12}$ based Composites" , J. Appl. Phys. 102, 103709 (2007).
9. Shi X., Zhang W., Chen L. D., Yang J., and Uher C., "Thermodynamic Analysis of the Filling Fraction Limits for Impurities in $CoSb_3$ based on ab initio Calculations" , Acta Mater. 56, 1733-1740 (2008).
10. Shi X., Kong H., Li C.-P., Yang J., Salvador J. R., Wang H., Uher C., Chen L., and Zhang W., "Low Thermal Conductivity and High Thermoelectric Figure of Merit in n-type $BaxYbyCo_4Sb_{12}$ Double-Filled Skutterudites" , Appl. Phys. Lett. 92, 182101 (2008).
11. Salvador J. R., Shi X., Yang J., Wang H., "Synthesis and Transport Properties of $M_3Ni_3Zn_4$ ($M = Zr$ and Hf): An Intermetallic Semiconductor" , Phys. Rev. B 77, 235217 (2008).
12. Salvador J. R., Yang J., Shi X., Wang H., and Wereszczak A. A., "Transport and mechanical property evaluation of $(AgSbTe)(1-x)(GeTe)(x)$ ($x=0.80, 0.82, 0.85, 0.87, 0.90$)" , J. Stat. Chem. 182, 2088 (2009).
13. Shi X., Yang J., Bai S., Yang J., Wang H., Salvador J. R., Zhang W., Chen L., Wong-Ng Winnie, "On the Design of High Efficiency Thermoelectric Clathrates through a Systematic Cross-substitution of Main-frame Elements" , Advanced Functional Materials 20, 755-763 (2010).
14. Shi X., Cho J. Y., Yang J., Wang H., Salvador J. R., Meinser G. P., "Thermoelectric Transport Properties of In_4Se_3 and In_4Te_3 Polycrystalline Compounds" , Appl. Phys. Lett. 96, 162108 (2010).
15. Salvador J. R., Yang J., Shi X., and Wang H., "Double-Filled Skutterudites of the Type $YbxCayCo_4Sb_{12}$: Synthesis and Properties" , J. Appl. Phys. 107, 043705 (2010).
16. Bai S. Q., Shi X.*., and Chen L. D., "Lattice Thermal Transport in $BaxREyCo_4Sb_{12}$ ($RE=Ce, Yb$, and Eu) Double-filled Skutterudites" , Appl. Phys. Lett., 96, 202102 (2010).
17. Shi, Xun; Yang, Jiong; Salvador, James; Chi, Miaofang; Cho, Jung; Wang, Hsin; Bai, Shengqiang; Yang, Jihui; Zhang, Wenqing; Chen, Lidong, "Multiple-Filled Skutteruditite Thermoelectric Figure of Merit through Separately Optimizing Electrical and Thermal Transports" , J. Am. Chem. Soc. 133 (20), 7837-7846 (2011).